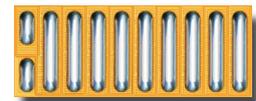


LiDAR (Light Distancing & Ranging)へのソリューション

eGaN[®]

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 高速スイッチング ・ 狭細なパルス幅の実現 ・ 高効率 ・ 小型デバイス ・ 温度に対する安定性 | <ul style="list-style-type: none"> ・ より高い正確性や微幅パルスの実現 ・ レーザーダイオード発熱の低減 ・ レーザードライバ発熱の低減 ・ システムの小型化に貢献、低インダクタンスで高い電流密度の実現 ・ 一環した動作が可能 |
|--|--|

EPCのeGaN FETは、MOSFETと比較して極めて高速なスイッチング能力があり、LiDARシステムに優れた分解能や高速応答、高い信頼性を提供すると共に、ゲート閾値の温度係数が低いことにより、リニアリティのある結果をもたらします。



Silicon Laser Driverによる描画



GaN Laser Driverによる描画